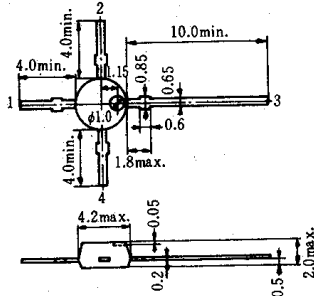


2SC3126, 2SC3127 2SC3128, 2SC3510

シリコン NPN エピタキシャル形
UHF/VHF 広帯域増幅用

SILICON NPN EPITAXIAL
UHF/VHF WIDE BAND AMPLIFIER

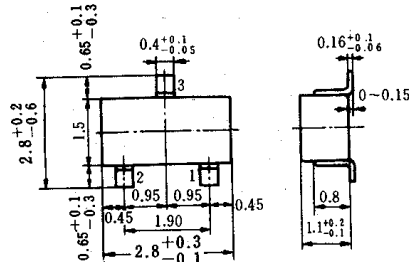
2SC3126



- 1. ベース : Base
- 2. エミッタ : Emitter
- 3. コレクタ : Collector
- 4. エミッタ : Emitter

(FPAK)

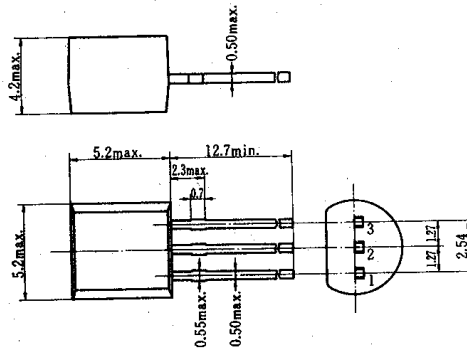
2SC3127



- 1. エミッタ : Emitter
- 2. ベース : Base
- 3. コレクタ : Collector

(MPAK)

2SC3128, 2SC3510



- 1. ベース : Base
 - 2. エミッタ : Emitter
 - 3. コレクタ : Collector
- (Dimensions in mm)

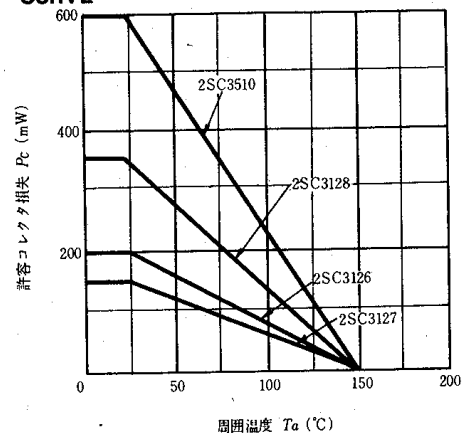
(JEDEC TO-92)

■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	Symbol	2SC3126	2SC3127*	2SC3128	2SC3510	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	20	20	20	20	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	12	12	12	12	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	3	3	3	3	V
コレクタ電流	I_C	50	50	50	50	mA
許容コレクタ損失	P_C	200	150	350	600	mW
接合部温度	T_j	150	150	150	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~+150	-55~+150	-55~+150	-55~+150	$^\circ\text{C}$

* 現品表示マークは「ID-」です。
* Marking is 「ID-」.

許容コレクタ損失の周囲温度による変化
MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION
CURVE



2SC3126,2SC3127,2SC3128,2SC3510

■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=10\mu\text{A}, I_E=0$	20	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=1\text{mA}, R_{BE}=\infty$	12	—	—	V
エミッタ遮断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=3\text{V}, I_C=0$	—	—	10	μA
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=12\text{V}, I_E=0$	—	—	0.5	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=20\text{mA}$	30	90	200	
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=5\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	—	0.9	1.5	pF
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=20\text{mA}$	3.5	4.5	—	GHz
電力利得	PG	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=20\text{mA}, f=900\text{MHz}$	—	10.5	—	dB
雑音指数	NF	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=5\text{mA}, f=900\text{MHz}$	—	2.2	—	dB